

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公開番号】特開2010-231778(P2010-231778A)

【公開日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【年通号数】公開・登録公報2010-041

【出願番号】特願2010-46014(P2010-46014)

【国際特許分類】

G 06 F 12/16 (2006.01)

G 06 F 12/00 (2006.01)

G 06 F 21/62 (2013.01)

【F I】

G 06 F 12/16 320 A

G 06 F 12/00 537 H

G 06 F 12/00 542 A

G 06 F 12/14 540 A

【手続補正書】

【提出日】平成25年2月4日(2013.2.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

システムであって、

不揮発性メモリと、

システム・オン・チップ(SoC)と、

を備え、

前記システム・オン・チップは、

非秘密データおよびメモリ管理データの内の少なくとも一方を含むデータをホワイトニングするよう構成された暗号化モジュールと、

前記暗号化モジュールに接続され、前記ホワイトニングされたデータを前記不揮発性メモリに格納するよう構成されたメモリインターフェースと、

を備える、システム。

【請求項2】

請求項1に記載のシステムであって、前記暗号化モジュールは、次世代標準暗号化方式(AES)エンジンを備える、システム。

【請求項3】

請求項1に記載のシステムであって、

前記データは、秘密データをさらに含み、

前記SoCは、前記秘密データおよび非秘密データを前記不揮発性メモリとやり取りするためのコマンドを前記メモリインターフェースに発行するよう構成されたファイルシステムをさらに含み、

前記メモリインターフェースは、前記不揮発性メモリ内の前記秘密データまたは前記非秘密データの格納を管理するための前記メモリ管理データを生成するよう構成されたメモリトランスレーションレイヤを備える、システム。

【請求項4】

請求項 3 に記載のシステムであって、前記ファイルシステムは、さらに、前記秘密データと共に暗号鍵を提供し、前記非秘密データと共に暗号鍵を提供しないよう構成されている、システム。

【請求項 5】

不揮発性メモリ内のユーザデータの格納を管理するための装置であって、前記ユーザデータのためのメモリ管理データを生成する手段と、前記メモリ管理データを格納する前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスを選択する手段と、

前記選択された第 1 の物理アドレスに基づいて、第 1 の暗号化シードを算出する手段と、

前記選択された第 1 の物理アドレスに格納するために、前記第 1 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを暗号化する手段と、を備える、装置。

【請求項 6】

請求項 5 に記載の装置であって、さらに、前記不揮発性メモリに前記暗号化されたメモリ管理データをプログラミングする手段を備える、装置。

【請求項 7】

請求項 5 に記載の装置であって、前記暗号化する手段は、次世代標準暗号化方式 (AES) エンジンを備え、前記第 1 の暗号化シードは、初期ベクトルを含む、装置。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の装置であって、さらに、前記 AES エンジンのための秘密鍵として所定の鍵を選択する手段を備え、前記所定の鍵は、前記選択された第 1 の物理アドレスの値に依存しない、装置。

【請求項 9】

請求項 5 に記載の装置であって、前記メモリ管理データは、前記ユーザデータの論理アドレスを前記ユーザデータの物理アドレスと関連づけるメモリマップ情報を含む、装置。

【請求項 10】

請求項 5 に記載の装置であって、さらに、第 1 の物理アドレスから第 2 の物理アドレスに前記メモリ管理データを移動させる手段を備え、

前記移動させる手段は、

前記第 1 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを復号するよう前記暗号化モジュールに指示する手段と、

前記第 2 の物理アドレスに基づいて第 2 の暗号化シードを算出する手段と、

前記不揮発性メモリの前記第 2 の物理アドレスに格納するために、前記第 2 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを暗号化するよう、前記暗号化する手段に指示する手段と、を備える、装置。

【請求項 11】

システムであって、暗号化モジュールと、不揮発性メモリを管理するためのメモリインターフェースであって、前記暗号化モジュールと通信するよう動作可能であるメモリインターフェースと、を備え、

前記インターフェースは、

非秘密データを含む情報を論理アドレスに格納するためのコマンドを受信し、

前記論理アドレスに基づいて暗号化シードを生成し、

前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスに格納するために、前記暗号化シードを用いて前記情報を暗号化するよう、前記暗号化モジュールに指示し、

前記第 1 の物理アドレスから前記不揮発性メモリの第 2 の物理アドレスに前記暗号化された情報を移動させる時に、前記情報の復号を迂回するよう構成されている、システム。

【請求項 1 2】

請求項 1 または 1 1 に記載のシステムであって、前記不揮発性メモリは N A N D 型フラッシュメモリを含む、システム。

【請求項 1 3】

請求項 1 1 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、さらに、前記コマンドが少なくとも 1 つの暗号化シードを欠いていることに基づいて、前記情報が非秘密データを含むことを検出するよう構成されている、システム。

【請求項 1 4】

請求項 1 1 に記載のシステムであって、

前記メモリインターフェースは、前記不揮発性メモリのガベージコレクションを開始するよう構成されており、

前記暗号化された情報は、前記ガベージコレクション中に、前記第 1 の物理アドレスから前記第 2 の物理アドレスに移動される、システム。

【請求項 1 5】

請求項 1 1 に記載のシステムであって、

前記メモリインターフェースは、ファイルシステムと通信するよう動作可能であり、

前記コマンドは、前記ファイルシステムから受信される、システム。

【請求項 1 6】

請求項 1 1 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、さらに、

前記論理アドレスを前記第 2 の物理アドレスに関連づけるように、メモリ管理データを更新し、

前記論理アドレスから前記情報を取り出すための読み出しコマンドを受信し、

前記メモリ管理データを用いて、前記第 2 の物理アドレスを決定し、

前記論理アドレスに基づいて前記暗号化シードを再生成し、

前記再生成された暗号化シードを用いて前記情報を復号するよう、前記暗号化モジュールに指示するよう構成されている、システム。

【請求項 1 7】

メモリインターフェースを用いて不揮発性メモリを管理する方法であって、

前記不揮発性メモリに格納する情報を受信する工程と、

前記情報が、秘密情報であるか非秘密情報であるかを検出する工程と、

前記検出に基づいて、プライベート鍵およびホワイトニング鍵のいずれかを選択する工程と、

前記選択された鍵を用いた前記情報の暗号化を有効にして、前記不揮発性メモリに格納する前記情報を暗号化する工程と、

を備える、方法。

【請求項 1 8】

請求項 1 7 に記載の方法であって、前記検出する工程は、前記プライベート鍵が、前記不揮発性メモリに前記情報を書き込むためのコマンドと共に受信されたか否かを判定する工程を備える、方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 7 に記載の方法であって、前記ホワイトニング鍵の値は、前記情報および前記情報に関連づけられたアドレスに依存しない、方法。

【請求項 2 0】

請求項 1 7 に記載の方法であって、さらに、

前記情報が秘密情報であると検出された場合に、第 1 の初期化ベクトルを受信する工程と、

前記情報が非秘密情報であると検出された場合に、第 2 の初期化ベクトルを生成する工程と、

前記情報が秘密情報であるか非秘密情報であるかに基づいて、前記第 1 および第 2 の初期化ベクトルのいずれかを選択する工程と、

を備える、方法。

【請求項 2 1】

請求項 1 7 に記載の方法であって、さらに、
前記受信した情報のメモリ管理データを生成する工程と、
前記不揮発性メモリに格納するために、前記ホワイトニング鍵を用いた前記メモリ管理
データの暗号化を有効にする工程と、
を備える、方法。

【請求項 2 2】

メモリインターフェースを用いて不揮発性メモリに格納する情報を準備する方法であつ
て、前記情報は論理アドレスに関連づけられており、前記方法は、
前記論理アドレスに基づいて前記情報を暗号化する工程と、
前記論理アドレスを前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスと対応づけるメモリ管理
データを生成する工程と、
前記不揮発性メモリの第 2 の物理アドレスに基づいて前記メモリ管理データを暗号化す
る工程と、
前記第 1 の物理アドレスに前記暗号化された情報を格納する工程と、
前記不揮発性メモリの前記第 2 の物理アドレスに前記暗号化されたメモリ管理データを
格納する工程と、
を備える、方法。

【請求項 2 3】

請求項 2 2 に記載の方法であって、さらに、
前記第 1 の物理アドレスから前記不揮発性メモリの第 3 の物理アドレスに前記暗号化さ
れた情報を移動させる工程を備え、
前記暗号化された情報は、前記移動させる工程の間、暗号化されたままである、方法。

【請求項 2 4】

請求項 1 7 または 2 2 に記載の方法であって、前記不揮発性メモリは N A N D 型フラッシュ
メモリを含む、方法。

【請求項 2 5】

請求項 2 2 に記載の方法であって、前記不揮発性メモリは、複数のページを有する N A
N D 型フラッシュメモリを含み、前記第 1 および第 2 の物理アドレスの各々は、前記複数
のページの内の 1 つに関連づけられる、方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 3】

上述の本発明の実施形態は、限定ではなく例示を目的としたものであり、本発明は、以
下の特許請求の範囲によってのみ限定される。

適用例 1：システムであって、不揮発性メモリと、システム・オン・チップ (S o C)
と、を備え、

前記システム・オン・チップは、非秘密データおよびメモリ管理データの内の少なくとも一方を含むデータをホワイトニングするよう構成された暗号化モジュールと、前記暗号化モ
ジュールに接続され、前記ホワイトニングされたデータを前記不揮発性メモリに格納するよう構成されたメモリインターフェースと、を備える、システム。

適用例 2：適用例 1 に記載のシステムであって、前記暗号化モジュールは、次世代標準
暗号化方式 (A E S) エンジンを備える、システム。

適用例 3：適用例 1 に記載のシステムであって、前記データは、秘密データをさらに含
み、前記 S o C は、前記秘密データおよび非秘密データを前記不揮発性メモリとやり取り
するためのコマンドを前記メモリインターフェースに発行するよう構成されたファイルシ

システムをさらに含み、前記メモリインターフェースは、前記不揮発性メモリ内の前記秘密データまたは前記非秘密データの格納を管理するための前記メモリ管理データを生成するよう構成されたメモリトランスレーションレイヤを備える、システム。

適用例 4：適用例 3 に記載のシステムであって、前記ファイルシステムは、さらに、前記秘密データと共に暗号鍵を提供し、前記非秘密データと共に暗号鍵を提供しないよう構成されている、システム。

適用例 5：不揮発性メモリ内のユーザデータの格納を管理するための装置であって、前記ユーザデータのためのメモリ管理データを生成する手段と、前記メモリ管理データを格納する前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスを選択する手段と、前記選択された第 1 の物理アドレスに基づいて、第 1 の暗号化シードを算出する手段と、前記選択された第 1 の物理アドレスに格納するために、前記第 1 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを暗号化する手段と、を備える、装置。

適用例 6：適用例 5 に記載の装置であって、さらに、前記不揮発性メモリに前記ランダム化されたメモリ管理データをプログラミングする手段を備える、装置。

適用例 7：適用例 5 に記載の装置であって、前記暗号化する手段は、次世代標準暗号化方式（AES）エンジンを備え、前記第 1 の暗号化シードは、初期ベクトルを含む、装置。

適用例 8：適用例 7 に記載の装置であって、さらに、前記 AES エンジンのための秘密鍵として所定の鍵を選択する手段を備え、前記所定の鍵は、前記選択された第 1 の物理アドレスの値に依存しない、装置。

適用例 9：適用例 5 に記載の装置であって、前記メモリ管理データは、前記ユーザデータの論理アドレスを前記ユーザデータの物理アドレスと関連づけるメモリマップ情報を含む、装置。

適用例 10：適用例 5 に記載の装置であって、さらに、第 1 の物理アドレスから第 2 の物理アドレスに前記メモリ管理データを移動させる手段を備え、前記移動させる手段は、前記第 1 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを復号するよう前記暗号化モジュールに指示する手段と、前記第 2 の物理アドレスに基づいて第 2 の暗号化シードを算出する手段と、前記不揮発性メモリの前記第 2 の物理アドレスに格納するために、前記第 2 の暗号化シードを用いて前記メモリ管理データを暗号化するよう、前記暗号化する手段に指示する手段と、を備える、装置。

適用例 11：システムであって、暗号化モジュールと、不揮発性メモリを管理するためのメモリインターフェースであって、前記暗号化モジュールと通信するよう動作可能であるメモリインターフェースと、を備え、

前記インターフェースは、非秘密データを含む情報を論理アドレスに格納するためのコマンドを受信し、前記論理アドレスに基づいて暗号化シードを生成し、前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスに格納するために、前記暗号化シードを用いて前記情報を暗号化するよう、前記暗号化モジュールに指示し、前記第 1 の物理アドレスから前記不揮発性メモリの第 2 の物理アドレスに前記暗号化された情報を移動させる時に、前記情報の復号を迂回するよう構成されている、システム。

適用例 12：適用例 1 または 11 に記載のシステムであって、前記不揮発性メモリは NAND 型フラッシュメモリを含む、システム。

適用例 13：適用例 11 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、さらに、前記コマンドが少なくとも 1 つの暗号化シードを欠いていることに基づいて、前記情報が非秘密データを含むことを検出するよう構成されている、システム。

適用例 14：適用例 11 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、前記不揮発性メモリのガベージコレクションを開始するよう構成されており、前記暗号化された情報は、前記ガベージコレクション中に、前記第 1 の物理アドレスから前記第 2 の物理アドレスに移動される、システム。

適用例 15：適用例 11 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、ファイルシステムと通信するよう動作可能であり、前記コマンドは、前記ファイルシステ

ムから受信される、システム。

適用例 1 6：適用例 1 1 に記載のシステムであって、前記メモリインターフェースは、さらに、前記論理アドレスを前記第 2 の物理アドレスに関連づけるように、メモリ管理データを更新し、前記論理アドレスから前記情報を取り出すための読み出しコマンドを受信し、前記メモリ管理データを用いて、前記第 2 の物理口케ーションを決定し、前記論理アドレスに基づいて前記暗号化シードを再生成し、前記再生成された暗号化シードを用いて前記情報を復号するよう、前記暗号化モジュールに指示するように構成されている、システム。

適用例 1 7：メモリインターフェースを用いて不揮発性メモリを管理する方法であって、前記不揮発性メモリに格納する情報を受信する工程と、前記情報が、秘密情報であるか非秘密情報であるかを検出する工程と、前記検出に基づいて、プライベート鍵およびホワイトニング鍵のいずれかを選択する工程と、前記選択された鍵を用いた前記情報の暗号化を有効にして、前記不揮発性メモリに格納する前記情報を暗号化する工程と、を備える、方法。

適用例 1 8：適用例 1 7 に記載の方法であって、前記検出する工程は、前記プライベート鍵が、前記不揮発性メモリに前記情報を書き込むためのコマンドと共に受信されたか否かを判定する工程を備える、方法。

適用例 1 9：適用例 1 7 に記載の方法であって、前記ホワイトニング鍵の値は、前記情報および前記情報に関連づけられたアドレスに依存しない、方法。

適用例 2 0：適用例 1 7 に記載の方法であって、さらに、前記情報が秘密情報であると検出された場合に、第 1 の初期化ベクトルを受信する工程と、前記情報が非秘密情報であると検出された場合に、第 2 の初期化ベクトルを生成する工程と、前記情報が秘密情報であるか非秘密情報であるかに基づいて、前記第 1 および第 2 の初期化ベクトルのいずれかを選択する工程と、を備える、方法。

適用例 2 1：適用例 1 7 に記載の方法であって、さらに、前記受信した情報のメモリ管理データを生成する工程と、前記不揮発性メモリに格納するために、前記ホワイトニング鍵を用いた前記メモリ管理データの暗号化を有効にする工程と、を備える、方法。

適用例 2 2：メモリインターフェースを用いて不揮発性メモリに格納する情報を準備する方法であって、前記情報は論理アドレスに関連づけられており、前記方法は、前記論理アドレスに基づいて前記情報を暗号化する工程と、前記論理アドレスを前記不揮発性メモリの第 1 の物理アドレスと対応づけるメモリ管理データを生成する工程と、前記不揮発性メモリの第 2 の物理アドレスに基づいて前記メモリ管理データを暗号化する工程と、前記第 1 の物理アドレスに前記暗号化された情報を格納する工程と、前記不揮発性メモリの前記第 2 の物理アドレスに前記暗号化されたメモリ管理データを格納する工程と、を備える、方法。

適用例 2 3：適用例 2 2 に記載の方法であって、さらに、前記第 1 の物理アドレスから前記不揮発性メモリの第 3 の物理アドレスに前記暗号化された情報を移動させる工程を備え、前記暗号化された情報は、前記移動させる工程の間、暗号化されたままである、方法。

適用例 2 4：適用例 1 7 または 2 2 に記載の方法であって、前記不揮発性メモリは N A N D 型フラッシュメモリを含む、方法。

適用例 2 5：適用例 2 2 に記載の方法であって、前記不揮発性メモリは、複数のページを有する N A N 型フラッシュメモリを含み、前記第 1 および第 2 の物理アドレスの各々は、前記複数のページの内の 1 つに関連づけられる、方法。